



2SA1585S (3CG1585S)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于低频放大。/Purpose: Low Frequency Amplifier.

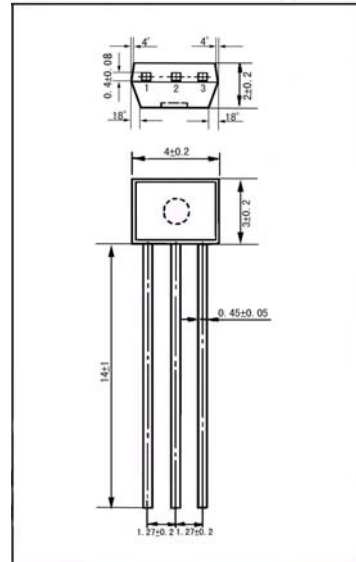
特点:饱和压降低, 电流增益特性好, 与 2SC4115S (3DG4115S) 互补。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, Excellent current gain characteristics; complementary pair with 2SC4115S (3DG4115S).

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-20	V
V_{CE0}	-20	V
V_{EB0}	-6.0	V
I_C	-2.0	A
I_{CP}	-5.0	A
P_C	0.4	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

TO-92S 单位:mm



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-50\ \mu\text{A}$ $I_E=0$	-20			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-20			V
V_{EB0}	$I_E=-50\ \mu\text{A}$ $I_C=0$	-6.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-20\text{V}$ $I_E=0$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$ $I_C=0$			0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-0.1\text{A}$	120		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2.0\text{A}$ $I_B=-0.1\text{A}$			-0.5	V
f_T	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$ $f=100\text{MHz}$		240		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		35		pF

h_{FE} 分档/ h_{FE} Classifications: Q:120~270 R:180~390



2SA1585S (3CG1585S)

